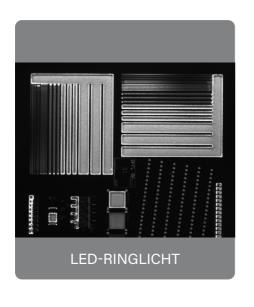
ANWENDUNGSHINWEIS









INSPEKTION EINES SILIZIUM-WAFERS

ELIMINIERUNG VON **REFLEXIONEN** UND **GLEICHMÄSSIGE AUSLEUCHTUNG** DER **MIKROSTRUKTUREN** EINES **SILIZIUM-WAFERS**



PROBLEMATISCH

Die Verwendung von Standard-LED-Beleuchtungen zur Inspektion eines Silizium-Wafers erzeugt unerwünschte Reflexionen auf der Oberfläche der Probe, die die Bildqualität beeinträchtigen.

UNSERE LÖSUNG

Mit dem L.E.S.S.-Licht profitiert der Anwender von einer gleichmäßigen Ausleuchtung mit neutralweißem Licht (5400°).

Das Licht der L.E.S.S.-Hellfeld-Beleuchtung trifft mit optimaler Intensität und ohne Wärmeabstrahlung von oben auf die Probe





ANWENDUNG

Abb. 1 wurde mit einem LED-Ring der Einstiegsklasse bei einem Arbeitsabstand von 100 mm aufgenommen. Es sind große Schattenbereiche vorhanden und es treten unerwünschte Reflexionen auf der Oberfläche des Wafers auf. Die verschiedenen Bereiche sind nicht gleichmäßig ausgeleuchtet, so dass einige Gravuren nicht zu erkennen sind. Abb. 2 wurde mit einem High-Level-Ring aus 80 LEDs in der gleichen Konfiguration wie in Abb. 1 aufgenommen. In diesem Fallkönnenwirweniger Reflexionen beobachten. Es bleiben jedoch einige Schatten, und die Gravuren sind nur teilweise zu erkennen.

Abb. 3 wurde mit L.E.S.S.-Ringlicht (BF-5400) bei

einem Arbeitsabstand von 100 mm aufgenommen. Die Oberflächenstruktur ist vollständig sichtbar. Es sind keine Schattenbereiche auf den Mikrostrukturen vorhanden, so dass alle Details beobachtet werden können. Gleichmäßigkeit Die der Beleuchtung führt zu scharfen, gut definierten Bildern, die eine schnellere und genauere und zuverlässigere Inspektion der Probe ermöglichen.













RISK CLASS 0 EN 62471 : 2006 EYE-SAFE CLASS 1 LASER PRODUCT ICE 60825-1 2014-05





L.E.S.S. SA

Av. de Longemalle 13 CH-1020 Renens, Switzerland

Tel: +41 21 552 07 10

